

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII
MOLDOVA

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2023 0010 (22) Data depozit: 2023.02.02 (71) Solicitant: INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD (54) Titlu: Procedeu de obținere a straturilor epitaxiale subțiri de TiO₂		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: <i>H01L 21/02</i> (2006.01) <i>H01L 21/18</i> (2006.01) <i>H01L 21/20</i> (2006.01) <i>H01L 21/205</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta): H01L 21/02, H01L 21/18, H01L 21/20, H01L 21/205, obține, depune, strat, epitaxial, TiO ₂ , dioxid de titan, vapori, izopropoxid de titan, argon, oxigen EA, CIS (Eapatis), SU: H01L 21/02, H01L 21/18, H01L 21/20, H01L 21/205, получение, осаждение, слой, эпитаксиальный, TiO ₂ , диоксид титана, пар, изопропоксид титана, аргон, кислород		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
Google.com		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorია*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Sang Hum Nam, Sang Jin Cho, Jin Hyo Boo. Growth behavior of titanium dioxide thin films at different precursor temperatures, Nanoscale Research Letters, 2012, nr. 7, art. nr. 89	1
A, D, C	M. I. B. Bernardi, E. J. H. Lee, P. N. Lisboa-Filho, E. R. Leite, E. Longo, J. A. Varela. TiO ₂ thin film growth using the MOCVD method, Materials Research, 2001, nr. 4(3), p. 1-5	1
A	Jia-long Yang, Ying Li, Fu Wang, Liang Zuo, Gu-Chul Yi, Wong Yong Choi. Structural and photocatalytic properties of TiO ₂ films fabricated on silicon substrates by MOCVD method, J Environ Sci (China), 2005, nr. 17(1), pag. 146-151	1
A	MD 151 Z 2010.10.31	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se	

	bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării, 2023.09.27	
Examinatoare, SĂU Tatiana	Document semnat digital